

2012.2.16.

シリコンテクノロジー分科会 第146回研究集会

日時： 2012年3月9日（金） 13:20~17:30

会場： 東京工業大学（大岡山キャンパス）蔵前会館 手島記念会議室
東急目黒線・大井町線 大岡山駅下車（駅前すぐ）

<http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/index.html>

担当： 接合技術専門委員会

オーガナイザ： 水野文二（パナソニック）委員長

コーディネーター： 筒井一生（東工大）、品田賢宏（早大）、上嶋和也（ルネサスエレクトロニクス）、富田隆治（ルネサスエレクトロニクス）

テーマ： 「次世代デバイスに向けた接合の高機能化」

趣旨： 比較的近い次の世代の主力になる CMOS デバイス、パワーデバイス等にとって、接合技術（ドーピング技術、接合特性制御、評価技術など）に課された課題もより高度で多角的になってきている。それらを克服する先進技術および基礎に立ち返った深い知見について議論する。

プログラム

13:20 開催にあたって

13:30 動作状態での sub-30-nm MOS-FET 内部の電位分布の断面観察
—電子線ホログラフィー— その場’ 観察によるポテンシャルマッピング—
五十嵐 信行（ルネサスエレクトロニクス）

14:00 メタル SD のためのシリサイド接合技術
右田 真司（産総研）

14:30 eDRAM セルトランジスタのリーク制御
岩崎 太一（ルネサスエレクトロニクス）

15:00 EDMR 分光法によるシリコン MOSFET 内部の結晶欠陥観察：
トランジスタの中で欠陥は何をしているのか？
梅田 享英（筑波大学）

15:30 休憩（15分）

15:45 GIDL ばらつきの定量評価とメカニズム考察
清水 咲子（東芝）

16:15 MIND+システム：半導体デバイス歩留まり向上イオン注入技術
二宮 史郎（SEN）

16:45 ワイドギャップ半導体パワーデバイスへの期待と現状
加地 徹（豊田中央研究所）

17:15 総合討論および閉会の辞

17:30 研究会終了

17:40 - 19:00 懇親会